

	<h2 style="color: #E67E22;">FDI045N10A</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDI045N10A</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDI045N10A.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 250 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDI045N10A
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	250 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	263W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5270pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	74nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 120A (Tc) 263W (Tc) Through Hole
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

FDI045N10A Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDI045N10A-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDI045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FDI045N10A E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDI047AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI038AN06A0 FAIRCHILD FDI038AN06A0 FAIRCHILD</p>	 <p>FDI038AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 80A TO-262AB</p>	 <p>FDI045N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>
 <p>FDI040N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI040N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A I2PAK</p>	 <p>FDI045N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 120A I2PAK-3</p>	 <p>FDI047AN08A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 80A TO-262AB</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDI045N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDI045N10A Datenblatt	FDI045N10A-Datenblätter	FDI045N10A PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDI045N10A
FDI045N10A Electronic	FDI045N10A-Komponenten	FDI045N10A-Verteiler	FDI045N10A-Bild	FDI045N10A-Teil
FDI045N10A Preis	FDI045N10A Hersteller	FDI045N10A Bild	FDI045N10A Aktie	FDI045N10A Inventar
FDI045N10A Neu	FDI045N10A Original	FDI045N10A garantiert	FDI045N10A RFQ	FDI045N10A Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited